



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ
с ОКБ»**

630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60
Тел. (383) 225-56-41, факс (383) 226-36-21
E-mail : okb@nzpp.ru <http://www.nzpp.ru>
ИНН 5402546039, КПП 540201001

Председателю диссертационного
совета 212.268.04 при ФБГОУ
«Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники»,
д.т.н., профессору
Шандарову С.М.

ул. Ленина, д. 40,
г. Томск, 634050

№ 04/004-555 от 10.10.2019

на № 20/3988 от 28.10.2019 г.

[О согласии ведущей организации]

Уважаемый Станислав Михайлович!

Акционерное общество «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» подтверждает своё согласие выступить ведущей организацией по диссертационной работе Федина Ивана Владимировича «Мощные быстродействующие диоды на основе гетероэпитаксиальных структур нитрида галлия» по специальности 01.04.04 – физическая электроника, на соискание учёной степени кандидата технических наук. Сведения, необходимые для размещения на сайте ТУСУР, прилагаются.

Приложение: сведения о ведущей организации на 2-х листах в 1 экз.

Генеральный директор

В.И. Исюк

Сведения о ведущей организации

по диссертационной работе Федина Ивана Владимировича «Мощные быстродействующие диоды на основе гетероэпитаксиальных структур нитрида галлия» по специальности 01.04.04 – физическая электроника, на соискание учёной степени кандидата технических наук

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Акционерное общество «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ»
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	АО «НЗПП с ОКБ»
Почтовый индекс, адрес организации	630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60
Веб-сайт	www.nzpp.ru
Телефон	(383) 225-56-41
Адрес электронной почты	gluhov@nzpp.ru
Список основных публикаций работников структурного подразделения, в котором будет готовиться отзыв, по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	<p>1. Глухов А.В., Рогулина Л.Г., Сажнев А.М. Двухканальный формирователь широтно-модулированного сигнала // Электросвязь. 2017. № 11. С. 62-65.</p> <p>2. Князев И.В., Палагин М.С., Косцов Э.Г., Глухов А.В. Разработка быстродействующего коммутатора оптических сигналов с динамически перестраиваемой длиной волны // Электронная техника. Серия 2: Полупроводниковые приборы. 2017. № 1 (244). С. 23-28.</p> <p>3. Dragunov V.P., Dorzhiev V.Y., Ostertak D.I., Atuchin V.V. A new autostabilization mechanism in the benet doubler circuit-based electrostatic vibrational energy harvester // Sensors and Actuators A: Physical. 2018. Т. 272. С. 259-266.</p> <p>4. Буханец Д.И., Никольский Ю.В., Корчак В.Ю. Снижение уровня шумов во входных трактах многофункциональных РЛС. // Новые исследования в разработке техники и технологий №2, 2015. С 58-65.</p> <p>5. Глухов А.В., Сединин В. И., Рогулин Л. Ю. Параметризация функциональных блоков интегральных микросхем на стадии проектирования. // Вестник СибГУТИ. 2015. №1. С. 3-14.</p> <p>6. В. А. Жмудь, В. М. Семибаламут, Л. В.</p>

Димитров. Структуры и методы цифрового управления колебательными объектами // Автоматика и программная инженерия = Automatics & Software Engineering. - 2016. - № 1 (15). - С. 46–57.

7. Базовкин В.М., Дворецкий С.А., Зверев А.В., Ковчавцев А.П., Макаров Ю.С., Сидоров Г.Ю., Якушев М.В., Глухов А.В., Фромичев Д.В., Смирнов И.А. Кремниевые интегральные микросхемы считывания для ИК-фотоприемных устройств на основе твердых растворов кадмий-ртуть-теллур // Техника радиосвязи. 2019. № 1 (40). С. 88-102.

8. Храпов М.О., Глухов А.В., Гридчин В.А., Калинин С.В. Анализ влияния температуры на электрофизические характеристики комплементарной пары вертикальных биполярных транзисторов // Известия высших учебных заведений. Электроника. 2017. Т. 22. № 1. С. 41-49.

9. Колчужин В.А., Князев И.В., Палагин М.С., Глухов А.В. Макромоделирование торсионного микроэлектромеханического резонатора // Нано- и микросистемная техника. 2017. Т. 19. № 2. С. 67-76.

Заместитель генерального
директора по научной работе




А.В. Глухов